
瑞萨半导体（北京）有限公司
土壤环境自行监测方案

委托单位： 瑞萨半导体（北京）有限公司

承担单位： 中检华盛（北京）检测有限公司

二〇二〇年六月



瑞萨半导体（北京）有限公司
土壤环境自行监测方案

项目负责人	白祥石	白祥石
编写人	史春雪	史春雪
	隰爽	隰爽
审核	许邵博	许邵博

编制单位：中检华盛（北京）检测有限公司

地址：北京市朝阳区化工路 51 号

邮编：100023

电话：58440121

瑞萨半导体（北京）有限公司土壤环境自行监测方案 专家评审意见

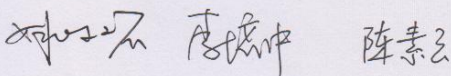
2019年6月4日，瑞萨半导体（北京）有限公司在北京市组织召开了《瑞萨半导体（北京）有限公司土壤环境自行监测方案》（以下简称“监测方案”）专家评审会。会议邀请了三位专家组成专家组（名单附后）。与会专家听取了编制单位中检华盛（北京）检测有限公司的介绍，经质询和认真讨论，形成专家意见如下：

一、编制单位根据《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》，通过现场踏勘、人员访谈、收集厂区资料及信息制定本监测方案。《监测方案》编制规范，结构完整，监测布点总体可行。《监测方案》修改完善后可作为下一步工作的依据。

二、建议

1. 核实甲基磺酸毒性参数，完善污染识别；
2. 结合工艺过程和场地条件，进一步明确各采样点的采样深度。

专家组签字：



2019年6月4日

瑞萨半导体（北京）有限公司土壤环境自行监测方案
专家评审会专家名单

2019年6月4日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	签名
1	李培中	轻工业环境保护研究所	高级工程师	李培中
2	陈素云	北京市勘察设计院有限公司	教授级高工	陈素云
3	姚玉君	北京市环境保护科学研究院	教授级高工	姚玉君

瑞萨半导体（北京）有限公司土壤环境自行监测方案 修改说明

2019年6月4日，瑞萨半导体（北京）有限公司在北京市组织召开了《瑞萨半导体（北京）有限公司土壤环境自行监测方案》（以下简称“监测方案”）专家评审会。会议邀请了三位专家组成专家组，与会专家听取了编制单位中检华盛（北京）检测有限公司的介绍。经质询和认真讨论，专家一致同意《监测方案》通过评审，并提出了完善建议。

根据专家意见，编制单位对《监测方案》进行了相应修改和完善，具体如下：

专家建议 1： 核实甲基磺酸毒性参数，完善污染识别；

补充 2.1.2.4 特征污染物识别章节。核实甲基磺酸作为一种有机强酸只有在与人体接触时会对人造成伤害，本项目含甲基磺酸的电镀液年使用量 20 吨左右，电镀液基本全部使用，只有少量作为电镀废水排放到污水处理站进行处理，不会对土壤、地下水造成危害，因此甲基磺酸可不作为本项目特征污染物。

专家建议 2： 结合工艺过程和场地条件，进一步明确各采样点的采样深度。

在 3.2.1 土壤监测布点原则与方法章节，表 11 土壤点位布设结果中补充各采样点的采样深度。

所有采样点均取表层土，深度 0.2m；S2 点位于原污水处理站西侧，原污水处理站内有地下废水储槽 3.1m 深，在储槽下 1m 深取样，取样深度 4.1m；S3 点位附近有污水管线，管线埋深 1m 左右，在管线下 1m 取深层土，取样深度 2m；S4 点位于水处理栋东侧，水处理栋地下紧急废水储槽 4m 深，在储槽下 1m 深取样，取样深度 5m；S5 点位附近有污水管线，管线埋深 1m 左右，在管线下 1m 取深层土，取样深度 2m；参照点 S0 同样需要取深层土，取样深度 4 米。

目 录

1 项目概述.....	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 目的和原则.....	1
1.2.1 目的.....	1
1.2.2 原则.....	2
1.3 调查与编制依据.....	2
1.4 评估标准.....	2
1.5 工作内容.....	3
1.5.1 地块内自行监测体系.....	3
1.5.2 地块内自行监测方案的确定.....	3
1.5.3 地块内自行监测结果评估.....	3
2 监测区域污染识别.....	5
2.1 地块环境识别.....	5
2.1.1 企业基本信息.....	5
2.1.2 污染源信息.....	6
2.1.2.1 厂区平面布置图.....	6
2.1.2.2 生产工艺及其原辅材料.....	9
2.1.2.3 三废排放情况.....	19
2.1.2.4 特征污染物识别.....	21
2.1.2.5 环境污染处理记录.....	22
2.1.3 迁移途径信息.....	22
2.1.3.1 区域地形地质.....	22
2.1.3.2 气候.....	24
2.1.3.3 区域水文与水文地质.....	24
2.1.3.4 项目所在场地水文地质分布条件.....	26
2.1.4 敏感受体信息.....	29
2.1.5 已有环境调查与监测信息概况.....	31
2.2 现场踏勘及人员访谈.....	32
2.2.1 现场踏勘.....	32
2.2.2 人员访谈.....	32
2.3 潜在污染区域识别.....	33
2.3.1 疑似污染源区域识别方法.....	33
2.3.2 重点区域及设施识别.....	33
2.3.3 潜在重点污染区域识别.....	38
3 自行监测计划.....	39
3.1 监测范围、监测对象、监测因子及监测频率.....	39
3.1.1 监测范围.....	39
3.1.2 监测对象.....	39
3.1.3 监测因子.....	39
3.1.4 监测频率.....	40

3.2 监测采样方案.....	40
3.2.1 土壤监测布点原则与方法.....	40
3.2.2 地下水监测井监测布点原则与方法.....	41
3.3 采样、保存、流转措施.....	43
3.3.1 采样措施.....	43
3.3.2 保存措施.....	44
3.3.3 流转措施.....	44
3.4 实验室分析测试.....	44
3.5 质量保证与质量控制.....	45
3.6 监测结果分析.....	45
3.7 监测报告编制.....	46

1 项目概述

1.1 项目背景

当今世界已从工业化进入信息化的发展阶段，信息产业作为新兴生产力的代表，其发展水平已成为衡量一个国家综合国力的重要标准。集成电路技术是信息产业和芯片技术的核心，是推动国民经济和社会信息化的关键技术，集成电路产业是当今促进全球经济发展的核心动力，也是目前世界上发展最为迅速和竞争最为激烈的一个产业。

瑞萨半导体（北京）有限公司为外资企业，是瑞萨科技株式会社的海外工厂之一，从事集成电路的后封装、测试生产制造。主要生产品种为 MCU（微控制器）、MSIG（混合信号集成电路）、SCR-LM（分离元器件）。

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》、《北京市土壤污染防治工作方案》的要求，切实推进北京市土壤污染防治工作，及时响应重点监管企业土壤环境自行监测（京环办〔2018〕47号）工作要求，提升土壤环境日常监管能力和手段，瑞萨半导体（北京）有限公司委托中检华盛（北京）检测有限公司对其企业所在场地进行土壤和地下水污染状况环境监测，初步确定企业用地内的土壤和浅层地下水是否被污染，编制相应的监测报告并依法向社会公开监测信息。

1.2 目的和原则

1.2.1 目的

本次工作的主要目的是参照《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》，识别企业存在土壤及地下水污染隐患的区域或设施，确定其对应的特征污染物，制定自行监测方案、建设并维护监测设施、记录和保存监测数据、编制年度监测报告，初步确定在产企业用地内的土壤和浅层地下水是否被污染，结合以往调查结果对污染物进行趋势分析。

1.2.2 原则

(1) 针对性原则：针对在产企业用地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为在产企业用地的环境管理提供依据。

(2) 规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范在产企业环境调查过程，保证自行方案编制及监测过程的科学性和客观性。

(3) 可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

1.3 调查与编制依据

(1) 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发[2016]31号）

(2) 《北京市环境保护局办公室关于印发<北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）>的通知》（京环函[2018]101号）

1.4 评估标准

(1) 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

(2) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

(3) 《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）

(4) 《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014）

(5) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

(6) 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）

(7) 《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）

(8) 《场地环境评价导则》（DB11/T 656-2009）

(9) 《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》（DB11/T 1278-2015）

(10) 《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》

(11) 工矿用地土壤环境管理办法（试行）（生态环境部令第3号）

(12) 建设用地土壤环境调查评估技术指南（原环境保护部公告2017年第72号）

1.5 工作内容

本次工作范围为瑞萨半导体（北京）有限公司地块范围内的土壤、地下水。主要工作内容如下：建立地块内自行监测体系、确定自行监测计划以及评估自行监测结果。本项目工作内容和程序见图 1。

1.5.1 地块内自行监测体系

调查地块内自行监测体系建立包括以下内容：地块环境识别、现场采样布点方案、采样设施建设、采样设施的运行和维护等内容。

1.5.2 地块内自行监测方案的确定

地块内自行监测计划的确定包括以下内容：自行监测的范围、自行监测的项目、自行监测的频率、现场采样、样品的保存、流转及测试、质量保证及质量控制等内容。

1.5.3 地块内自行监测结果评估

自行监测结果评估包含以下内容：土壤污染物监测结果的评估、地下水污染物监测结果的评估、土壤及地下水污染物污染趋势分析。

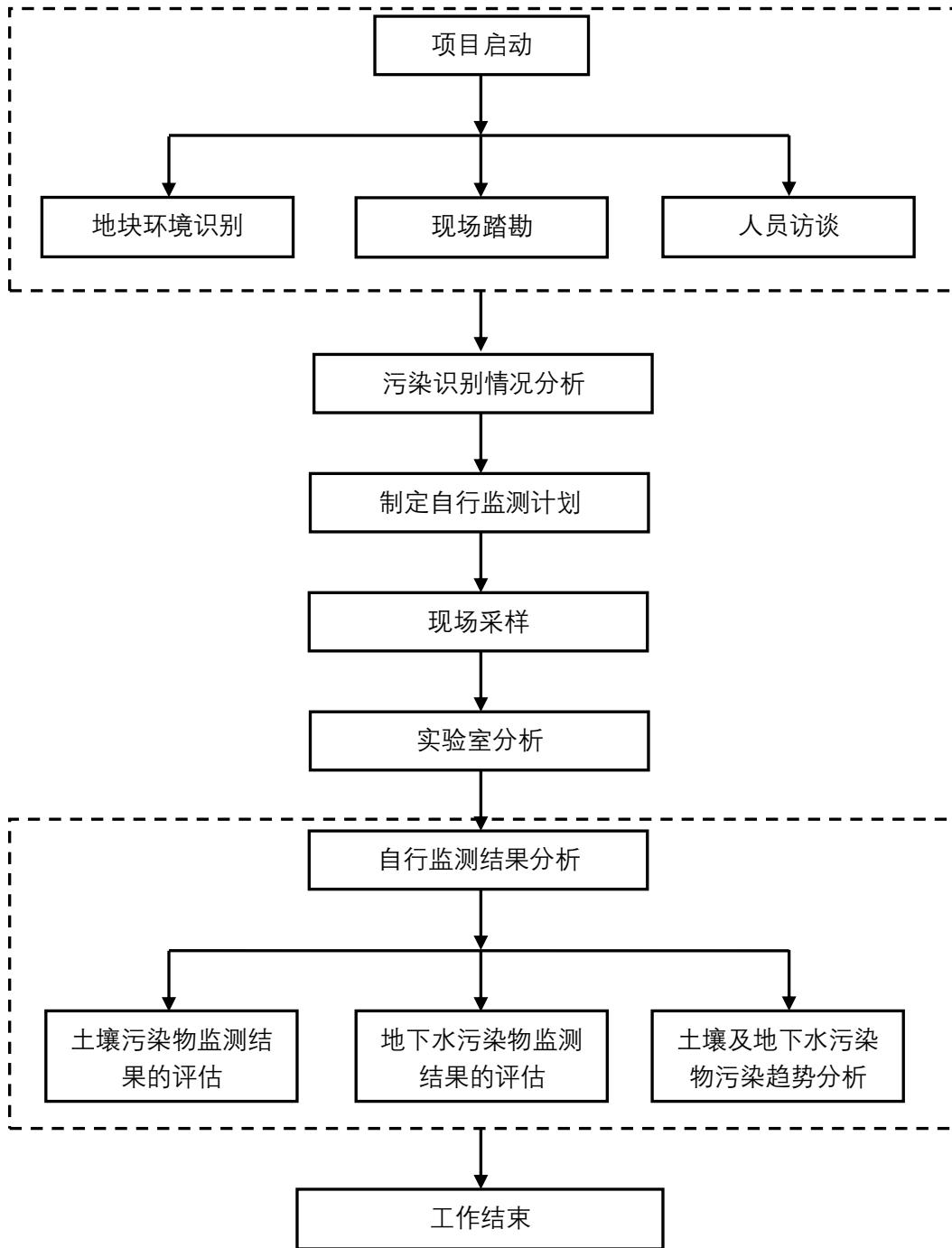


图 1 本项目工作步骤

2 监测区域污染识别

2.1 地块环境识别

2.1.1 企业基本信息

瑞萨半导体（北京）有限公司为外资企业，其公司前身为三菱四通集成电路有限公司（简称 MSSC），成立于 1996 年 3 月。之后公司经两次更名：2003 年 9 月，更名为瑞萨四通集成电路（北京）有限公司；2005 年 10 月，更名为瑞萨半导体（北京）有限公司。现公司注册资金 9044 万美元。

公司现有工程经过三次项目建设：

（1）三菱四通集成电路有限公司

1996 年 6 月“三菱四通集成电路有限公司项目”建设工程竣工，建成第一栋厂房 A 栋（组装车间），另外还有管理栋、机械栋、守卫所、废品库、鼓风机房、蒸汽计量小室等其他附属设施，1998 年 12 月通过环保验收。

（2）三菱四通集成电路有限公司一期扩建工程

2003 年 12 月，“三菱四通集成电路有限公司一期扩建工程项目”竣工，建成第二栋厂房即 T 栋（测试车间），2004 年 10 月通过环保验收。

（3）瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程

2012 年 10 月“瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程项目”竣工，建设生产栋、水处理栋等，2013 年 2 月通过环保验收。

瑞萨半导体（北京）有限公司公司是瑞萨科技株式会社的海外工厂之一，从事集成电路的后封装、测试生产制造。主要生产品种为 MCU（微控制器）、MSIG（混合信号集成电路）、SCR-LM（分离元器件）。

公司相关基本信息如下表 1 所示。

表 1 瑞萨半导体（北京）有限公司基本信息

序号	项目	基本信息
1	企业名称	瑞萨半导体（北京）有限公司
2	法定代表人	福本好成
3	公司地址	北京市海淀区上地信息产业基地 8 街 7 号
4	企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
5	企业规模	2417 人
6	营业期限	1996 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日
7	社会统一信用代码	91110108600042247X
8	所述工业园区或集聚区	海淀区上地信息产业基地
9	许可经营范围	制造半导体；设计开发半导体及其相关软件产品，在国内外销售本公司产品提供售后服务；承接半导体的委托生产业务，半导体的受托检查业务；有关上述各项的附带业务（组立、测试、研磨及设计等）；自有厂房出租业务（仅限房产证京房权证市海涉外字第 10275 号，位于第二层的部分厂房，面积 5200 平米，京房权证海字第 417667 号，位于第四层的部分厂房，用于厂房即配套用房）
10	登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局

2.1.2 污染源信息

2.1.2.1 厂区平面布置图

项目用地位于北京市海淀区上地八街 7 号信息产业基地的瑞萨半导体（北京）有限公司用地范围内。现有总用地面积 147377m²，使用面积 97924m²，建筑面积 53251m²。用地北临上地九街、南邻上地八街、东临上地东路、西邻上地西路，东西长约 563m，南北宽为 208~299m。厂区平面布置图见图 2，区域位置图见图 3。

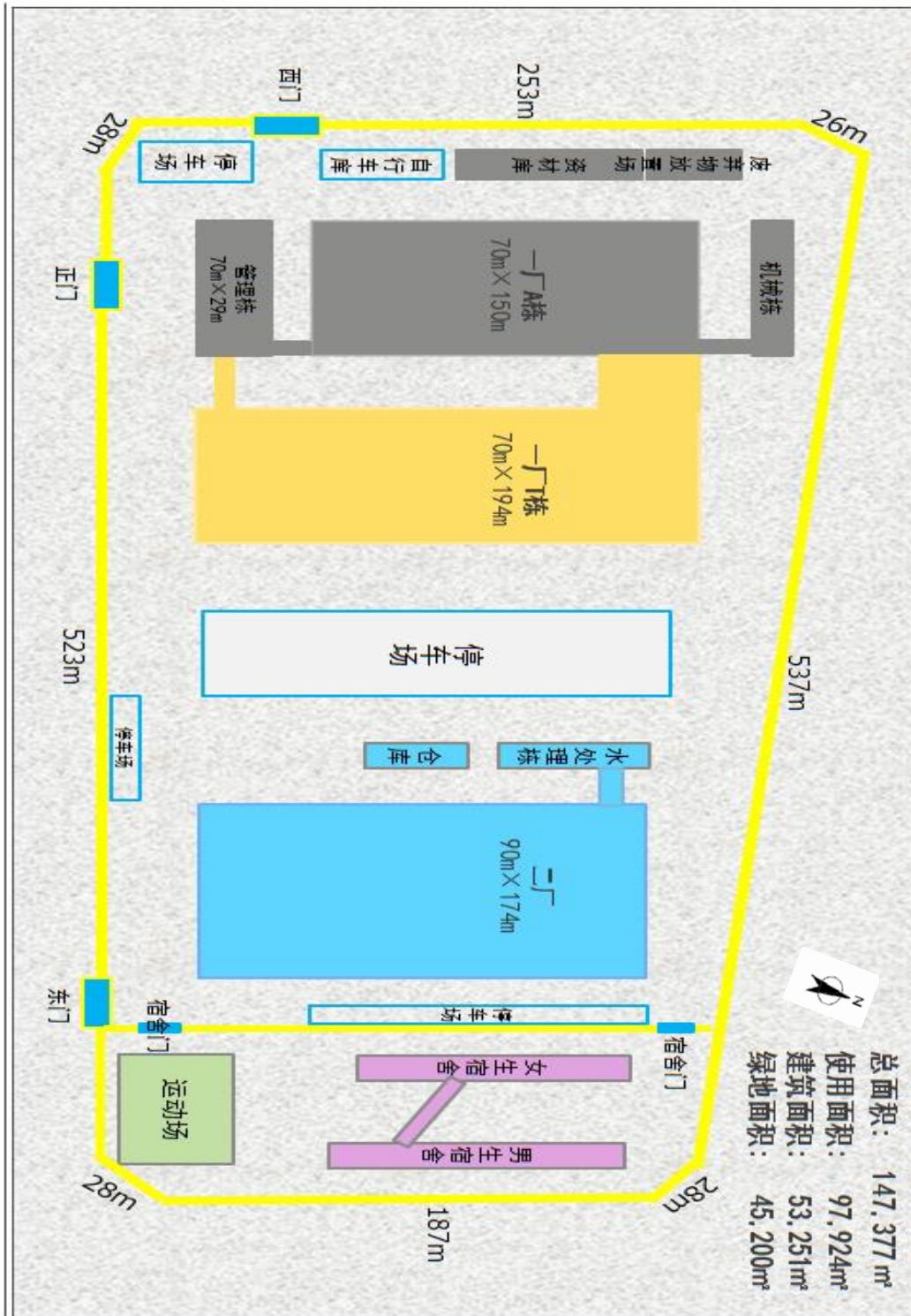


图 2 厂区平面布置图

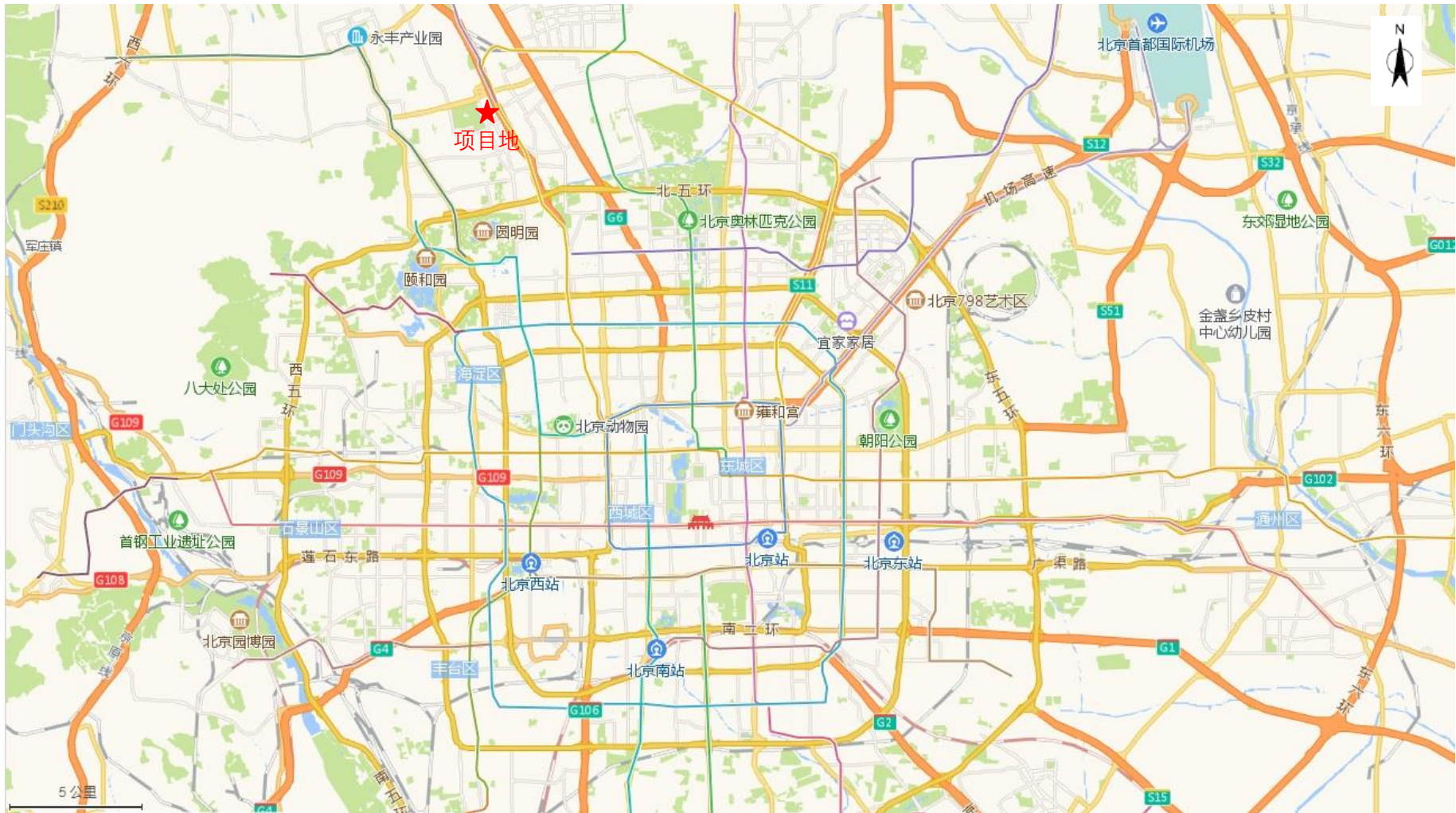


图 3 项目地理位置图

2.1.2.2 生产工艺及其原辅材料

瑞萨半导体（北京）有限公司为集成电路封装测试生产厂，现有工程共有电镀生产线 5 条，年封装测试生产能力 7.536 亿块/年。

主要生产工艺流程见图 4-1、4-2、4-3 所示。使用原辅料见表 2。

工序名称	示意图	描述	使用原材料		排出污染物
划片	<p>硅圆片 → 芯片</p>	<p>将单晶硅圆片上分布的成百上千的写入电路的芯片划制成单片。在劈刀切割芯片同时，用超纯水清洗掉硅屑，因此产生划片排水</p>	直材	单晶硅圆片	①划片排水(含有硅屑)
			动力	①纯水 ②干燥压缩空气 ③电气	
粘片	<p>芯片 框架 银浆树脂</p>	<p>将每一芯片通过粘接剂固定在带有许多管脚的金属框架中央</p>	直材	金属框架 焊锡或银浆树脂粘接剂	
			动力	①氮气 ②干燥压缩空气 ③电气 ④真空	
键合	<p>金线</p>	<p>在这一过程中，芯片电极与框架之间通过金线或铝线连接起来。</p>	直材	金线或铝线	
			动力	①干燥压缩空气 ②电气	
塑封	<p>树脂</p>	<p>裸露的芯片通过模具，用树脂进行封装</p>	直材	树脂	废树脂屑
			动力	①真空 ②干燥压缩空气 ③电气 ④低温冷却水	①热排气
打印	<p>打印</p>	<p>在制品表面打印上产品型号及批号等内容。</p>	直材		
			动力	①真空 ②干燥压缩空气 ③电气	
电镀	<p>镀锡</p>	<p>为使芯片牢固地焊接在电路板上，在制品外框架管脚表面进行镀锡或铅处理</p>	直材	电镀液，化学药液，锡铜或锡铅半田球等	废半田 废液压油
			动力	①真空 ②干燥压缩空气③电气 ④生产杂用水 ⑤一次水⑥纯水	酸碱废水 电镀废水 电镀污泥 酸排气
管脚加工	<p>管脚加工</p>	<p>切除框架管脚外不用的部分，并将管脚部加工成所需要的形状，到此芯片的制造就完成了。</p>	直材		废框架
			动力	①真空 ②干燥压缩空气 ③电气	
测试	<p>处理机 测试机</p>	<p>从测试开始是检验产品是否为良品。首先通过测试机来检查产品的电特性，必要时还要进行老化测试。</p>	直材		热排气
			动力	①真空②干燥压缩空气 ③电气④低温冷却水 ⑤液氮	
外观日视检查		<p>测试合格品包装出库前部分进行外观检查</p>	直材		
			动力	①电气 ②干燥压缩空气	
包装出厂	<p>托盘 包装箱</p>	<p>检查后良品包装后出厂</p>	直材		
			动力	①电气②干燥压缩空气	

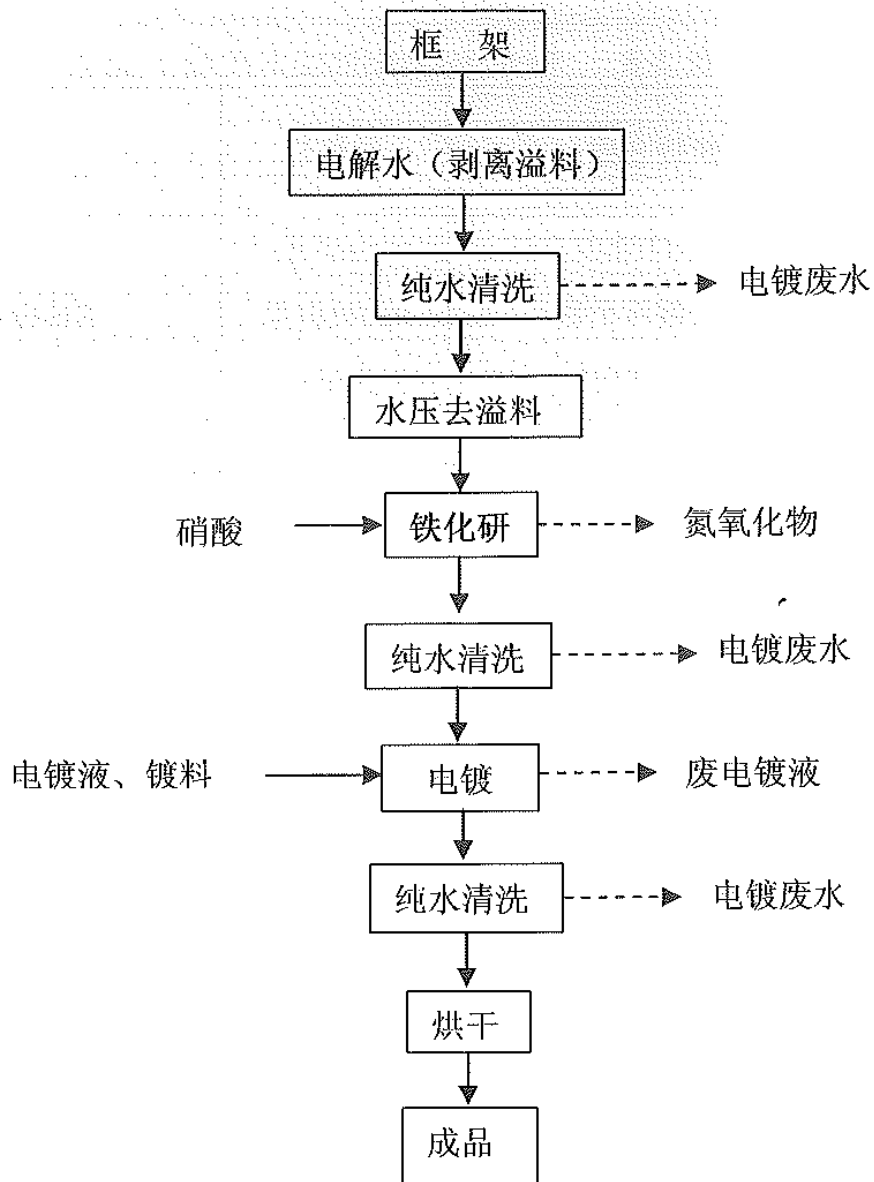


图 4-2 铁镍制框架电镀工艺流程图

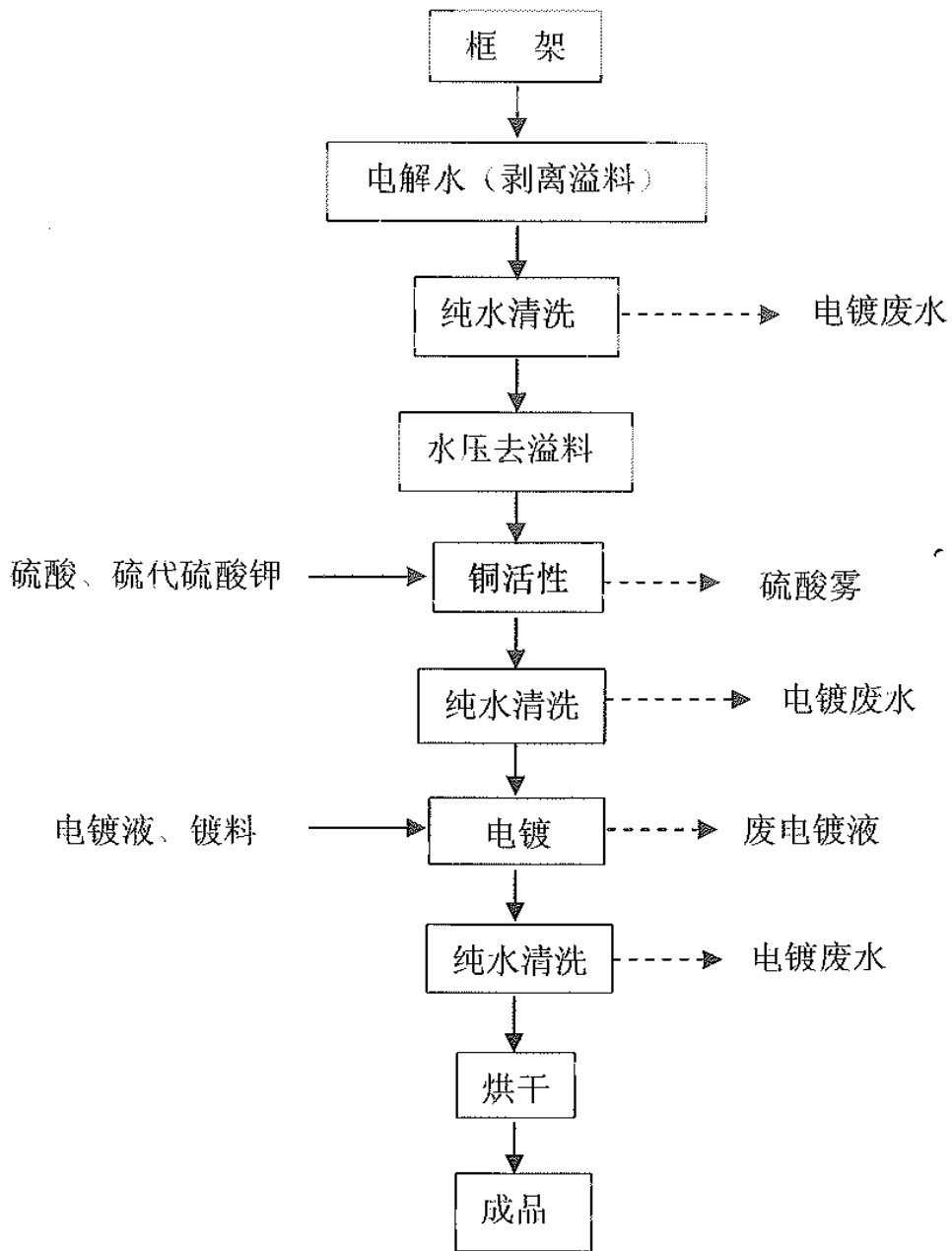


图 4-3 铜制框架电镀工艺流程图

1.工艺流程简述:

(1) 划片: 将单晶硅圆片上分布的成百上千的写入电路的芯片切成单片。在切刀切割芯片同时, 用纯水清洗掉硅屑, 因此产生划片废水。

(2) 贴片: 将每一个芯片通过粘接剂固定在带有许多管脚的金属框架中央。粘接剂通常使用银浆树脂。

(3) 引线键合: 用金属引线将芯片上的电极和外壳框架(条带)的电极连接起来。

引线键合是集成电路制造过程中重要的工序之一, 它起着连接前道工序产品“芯片”和后道工序产品“模块”(集成电路外管脚)之间的桥梁作用。引线键合工序有各种形式, 世界上目前比较通用的是“超声波热压法”, 也就是我们通常所说的“物理法”。本项目采用此方法完成该工序。超声波热压法的优点是工艺容易实现、质量高、能耗小, 适合大规模集成电路生产。

超声波热压法无焊剂和助焊剂, 它是一种仅利用超声波、压力和温度实现的物理方法。超声波、压力、温度又称为超声波热压法的“三元素”。其中超声波的作用主要是破坏芯片键合压点表面的致密氧化层, 露出洁净的接触界面, 使金属细线在一定的压力和温度情况下与压点接合, 整个键合过程无任何排放物产生。由此可见, 项目采用的模块键合工艺是不会产生废气的。

(4) 塑封: 裸露的芯片通过模具, 用树脂进行封装, 保护其不受外部环境的损害。

(5) 打印: 在制品表面打印上产品型名及批号等内容。

(6) 电镀: 为使芯片牢固地焊接在电路板上, 在制品外框架管脚表面进行电镀对引线起到防护作用。(详见图 4-2、图 4-3)。

本项目电镀工艺特点主为镀种单一(芯片引线), 电镀量(面积)小、无铅及污染物产生浓度低、产生量小。

(7) 管脚加工: 切除框架管脚外不用的部分, 并将管脚部加工成所需要的形状, 到此芯片的制造就完成了。

(8) 测试: 从测试开始检验产品是否为良品, 先通过测试机来检查产品的电特性, 必要时还要进行老化测试。

2.项目原辅料使用情况

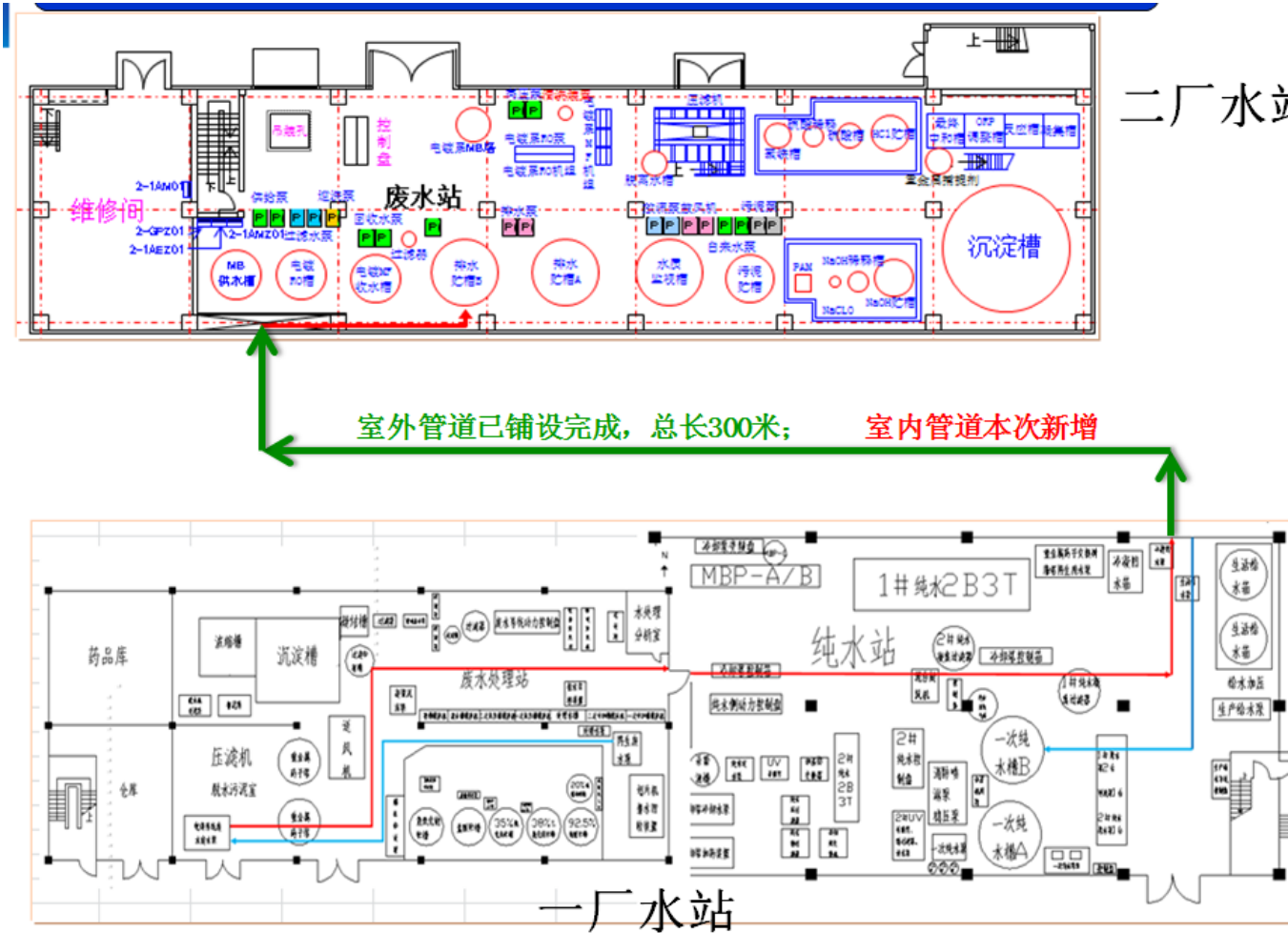
项目原辅料使用情况见下表：

表 2 原辅材料一览表

序号	名称	单位	年使用量	
1	框架	个	5.64 亿	
2	树脂	千克	67.34 万	
3	镀料	焊锡	米	33.5 万
		锡铜半田球	千克	15568.8
4	硫酸、硝酸	吨	37.5	
5	金线	千米	19478000	
6	电镀液（甲基磺酸、锡离子、铜离子、硫酸组成）	千克	8785.5	
7	托盘	个	1390840	
8	料管	根	8197425	

3. 废水处理工艺:

电镀废水处理采用絮凝+沉淀+中和的处理工艺；酸碱废水处理采用中和处理的工艺；划片废水处理采用 UF 膜过滤的处理工艺。



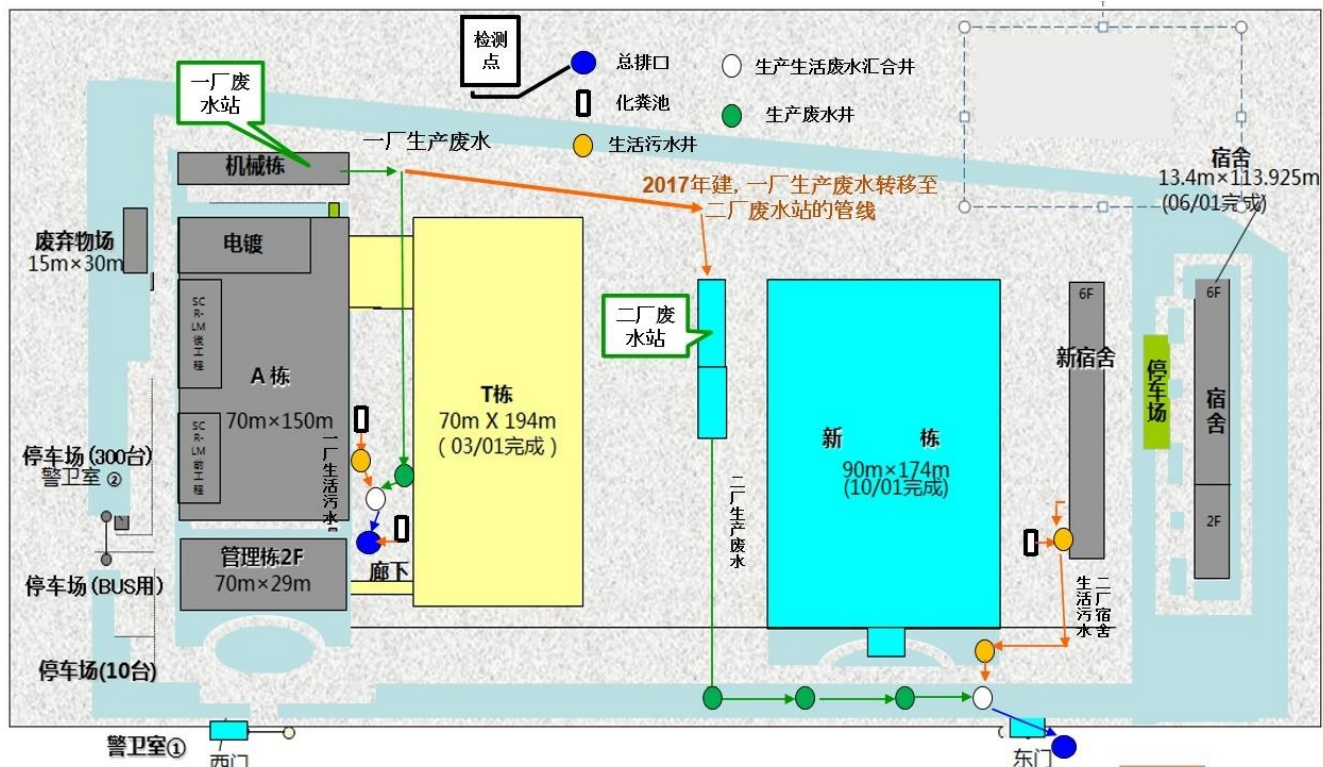


图 1-10 污水处理站建筑平面图：一厂污水处理站，长 10.15m，宽 7m，高 3.1m

为废水处理站和纯水处理站，二层为空压机站和冷冻机站；地下废水储槽 3.1m 深，储槽地面、墙面耐酸碱装修（FRP 玻璃钢）；自运行以来，未发现渗漏情况。

二厂污水处理站建筑结构：二层框架结构，长*宽=56*12m，层高 7m，一层为废水处理站，二层为纯水处理站；地下紧急废水储槽 4.0m 深，储槽地面、墙面耐酸碱装修（frp 玻璃钢）；自运行以来，未发现渗漏情况。

4. 含铅工艺历史沿革

本项目现使用的电镀工艺特点主为镀种单一（芯片引线），电镀量（面积）小、无铅及污染物产生浓度低、产生量小。但在 2015 年之前，项目曾使用含铅电镀工艺。

含铅合金电镀工艺长期在电子产品制造技术中被广泛应用，尤其是 Sn-Pb 共晶焊料作为低温合金的工艺。但是由于大量电子产品废弃物及旧家用电器逐渐造成的铅污染，对人类生存的地球环境也形成很大的危害性，因此，防止铅污染已经成世界潮流。日本已经于 1998 年开始在大公司实施无铅化制造。2003 年以前，日本的索尼、东芝、日立、NEC 等大公司已基本实现电子产品无铅化。2003

年，我国信息产业部发布“电子信息产品污染防治管理办法”文件，规定从 2006 年 7 月 1 日起，全面禁止在电子信息产品生产过程中使用含铅的焊料，要求投放市场电子、电气产品不含铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚和联苯 6 种有害物质。同时国家环保部 2011 年发布了《重金属污染综合防治“十二五”规划》、《重金属污染综合防治“十二五”规划实施考核办法》《重点重金属污染物排放量指标考核细则》、北京市发布了《北京市重金属污染综合防治“十二五”规划年度实施方案》等文件。电子市场的发展趋势及环境保护的严格执行将迫使含铅电子产品无法进入市场，因此半导体电子产品采用无铅电镀工艺就成为企业面临的紧迫任务。

电镀工程作为半导体封装测试的重要一环，作为环保要求的一部分，工业用铅对人体的危害很大，因此电镀的无铅化已经成为发展趋势。瑞萨公司从 2004 年开始导入电镀无铅化，有铅品产量逐年降低。2004 年 7 月产量 1700 万个，占总体产量比例 95%，到 2009 年以后达到总产量的 0.5%，2013 年以后更是达到总产量的 0.1%，直至 2015 年 4 月开始终止有铅产品的生产，2015 年 6 月有铅生产完全取消。至 9 月，实施了后续无铅化变更管理、装置、动力管路无铅化清扫，无铅生产参数、设定追加等，9 月底彻底实现了 SnCu 制品量产。同时完成了有铅相关生产材料废弃处置（药液/锡球/分析相关试剂/动力），有铅相关专用工具废弃等。

经过 5 年持续不间断的努力，企业最终实现了有铅生产的完全取消，将 P103 电镀生产线由锡铅电镀（Sn-Pb Plating）改造为锡铜电镀（Sn-Cu Plating），实现了电镀生产的无铅化。

表 3 历史铅使用量一览表

年份	铅使用量(KG)
2003	676
2004	899
2005	726
2006	443
2007	482
2008	345
2009	454
2010	20
2011	33
2012	2
2013	2
2014	1
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0

原有铅电镀工艺主要在一厂 A 栋，直至 2015 年完全取消。

2.1.2.3 三废排放情况

(1) 废气排放及处理情况

依据企业环评及环境保护验收资料可知，项目废气污染源主要为电镀工序产生的酸性废气（硫酸雾和氮氧化物）、食堂油烟废气。酸性废气通过酸性废气处理系统（废气洗涤塔、通风机、排气管和加药系统）后由 13 米和 15 米排气筒排放，食堂油烟经过油烟净化器后排放。

(2) 废水排放及处理情况

依据企业环评及环境保护验收资料可知，项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水包括划片废水、电镀废水、酸碱废水及一般排水（冷却塔废水和洗衣废水），生产废水经处理装置处理达标后排入市政管网。

生活废水排入市政管网。

(3) 固体废物排放及处理记录

根据相关资料可知：项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾及时清运；一般工业固废包括封塑工序产生的边角料、切筋工序产生的边角料、不合格和废包装材料等，该部分固体废物基本可以回收利用；危险废物包括设备维修产生的废机油、废有机溶液、废水处理污泥等，均委托有资质危险废物处理单位处置。

表 4 项目生产三废排放情况表

序号	分类	污染物名称	产生工序	处理措施
1	废气	硫酸雾、氮氧化物	电镀	酸性废气处理系统
2	废水	划片废水：ss	划片工序	水处理栋处理
		电镀废水：pH、锡、镍、铜	电镀	
		酸性废水：pH	洗涤塔	
3	固废	一般工业固废：边角料、不合格和废包装材料	封塑、切筋、包装工序	回收处理
		危险废物： 废机油 废有机溶液（松香水、盐酸、丙酮） 废水处理污泥（锡、镍、铜） 废滤芯 废溶液瓶 酸桶	设备维修 电镀工序 污水处理 废气处理	有资质单位处理

危险废物排放量见下表：

表 5 危险废物排放量一览表

序号	名称	2018 年排放量 (kg)
1	废机油	605
2	废有机溶液（松香水、盐酸、丙酮）	419
3	废水处理污泥（锡、镍、铜）	43377
4	废滤芯	8951
5	废溶液瓶	151
6	酸桶	6859

2.1.2.4 特征污染物识别

根据以上分析，项目产生的可能对土壤地下水有影响的污染物主要包括：电镀废水（pH、锡、镍、铜）、电镀液（甲基磺酸、锡离子、铜离子、硫酸组成）、废水处理污泥（锡、镍、铜）、废机油等。

① 电镀液中甲基磺酸毒性识别

甲基磺酸也称甲烷磺酸，是一种有机强酸、非氧化性酸。

甲基磺酸外观为无色或浅黄色透明粘稠油状液体，低温下为固体。熔点 20℃，沸点 167℃（13.33kPa），122℃（0.133kPa）。相对密度 1.4812（18℃），折射率 1.4317（16℃）。热稳定性较好，耐沸水和热碱液（对沸水、热碱液不分解），溶于水、醇和醚类，不溶于烷烃、苯、甲苯等。对金属铁、铜、银、铅等有强腐蚀作用，但在含有 0.5~1%硫酸时对不锈钢不腐蚀。因此，不锈钢可作贮器和生产设备。

甲基磺酸是重要的有机合成和医药中间体，常作为溶剂、烷基化和脂化试剂应用于有机合成中；另外，它又是理想的整平剂和光亮剂。甲基磺酸盐电镀液已经应用到锡和锡铅合金电镀上，许多新电镀液性能很大程度上取决于所用的甲基磺酸质量的好坏。甲基磺酸用作溶剂，烷化酯化和聚合反应的催化剂。99%含量的该产品主要用于医药方面，70%含量的该产品主要用于电镀行业。

甲基磺酸属酸性腐蚀品，对眼睛、皮肤和粘膜等人体组织有强刺激性，故在与其接触中应注意防护。甲基磺酸对粘膜、上呼吸道、眼和皮肤有强烈的刺激性。吸入后，可因喉及支气管的痉挛、炎症、水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后出现烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

由上可知，甲基磺酸作为一种有机强酸只有在与人体接触时会对人造成伤害。本项目含甲基磺酸的电镀液年使用量 20 吨左右，电镀液基本全部使用，只有少量作为电镀废水排放到污水处理站进行处理，不会对土壤、地下水造成危害，因此甲基磺酸可不作为本项目特征污染物。

② 废机油

本项目机油主要是生产车间设备维修中产生的润滑油，但产生量很小（年产生量约 600kg），且都发生在厂房内部，厂房地面硬化及防渗措施完好，且废机油及时收集作为危废处理，厂区内地面未见油渍，因此本项目废机油可不作为特

征污染物。

③ 锡、镍、铜

本项目生产过程中会涉及到锡、镍、铜等重金属材料，且电镀废水、废电镀液、废水处理污泥中都含有锡、镍、铜离子；考虑到以前的电镀工艺还涉及到含铅工艺，重金属对土壤、地下水的影响较大且易富集不易讲解，因此把锡、镍、铜、铅作为本项目的特征污染物。

2.1.2.5 环境污染处理记录

自 1996 年建厂至今，瑞萨半导体（北京）有限公司尚未发生过因管道或地下设施泄漏、环境污染事故等重大危害而报批北京市环保局或北京市人民政府等机构的事件。

2.1.3 迁移途径信息

2.1.3.1 区域地形地质

该项目所在的北京市海淀区上地信息产业基地海拔 44m 左右，位于永定河冲洪积扇平原，中上部为缓斜冲积平原，地形平坦。其所在区域的地形见图 5。

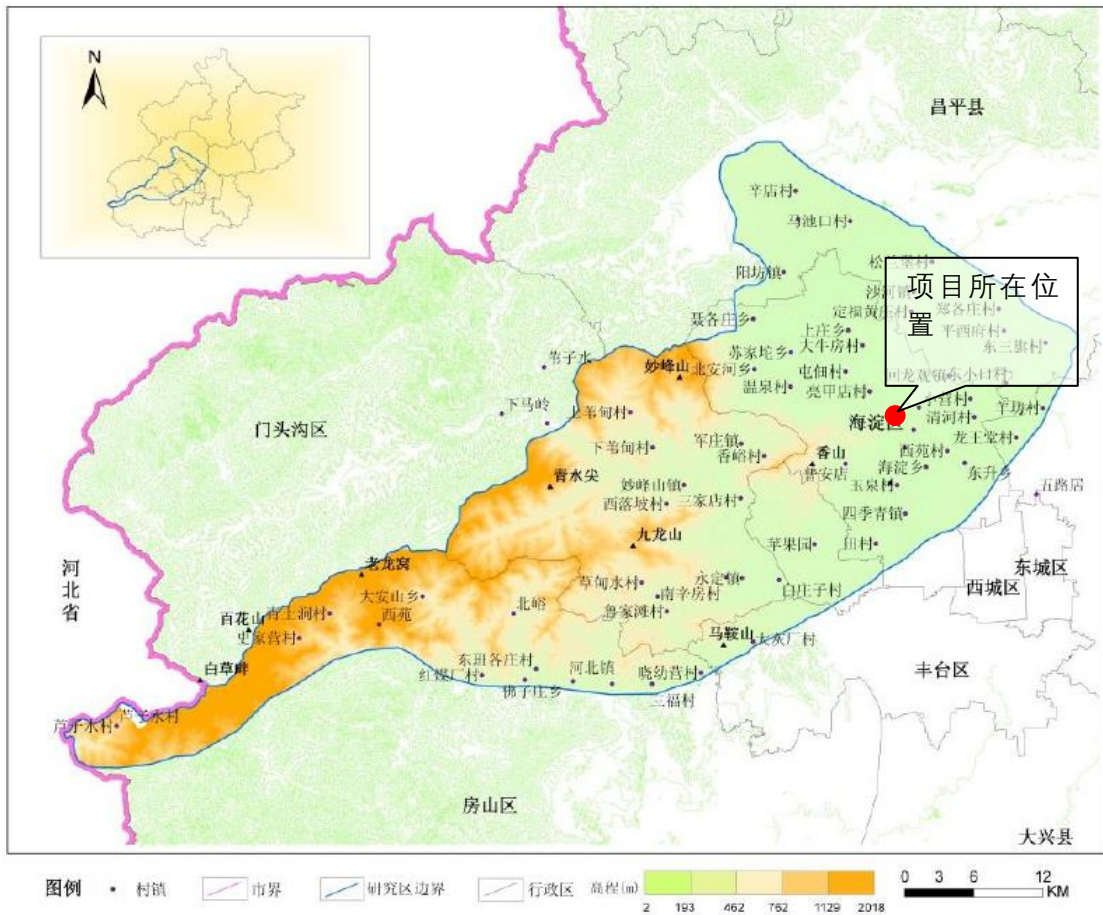


图 5 项目所在区域的地形图

海淀区上地信息产业基地地质状况优良，其基岩面起伏平稳，无断裂带。项目地地层表层为人工填土，其下均为一般第四纪冲洪积成因的粘性土、砂土、粉土、砂类土；第四纪之下基岩为早、中侏罗统，详见图 6 项目所在区域基岩地质图。

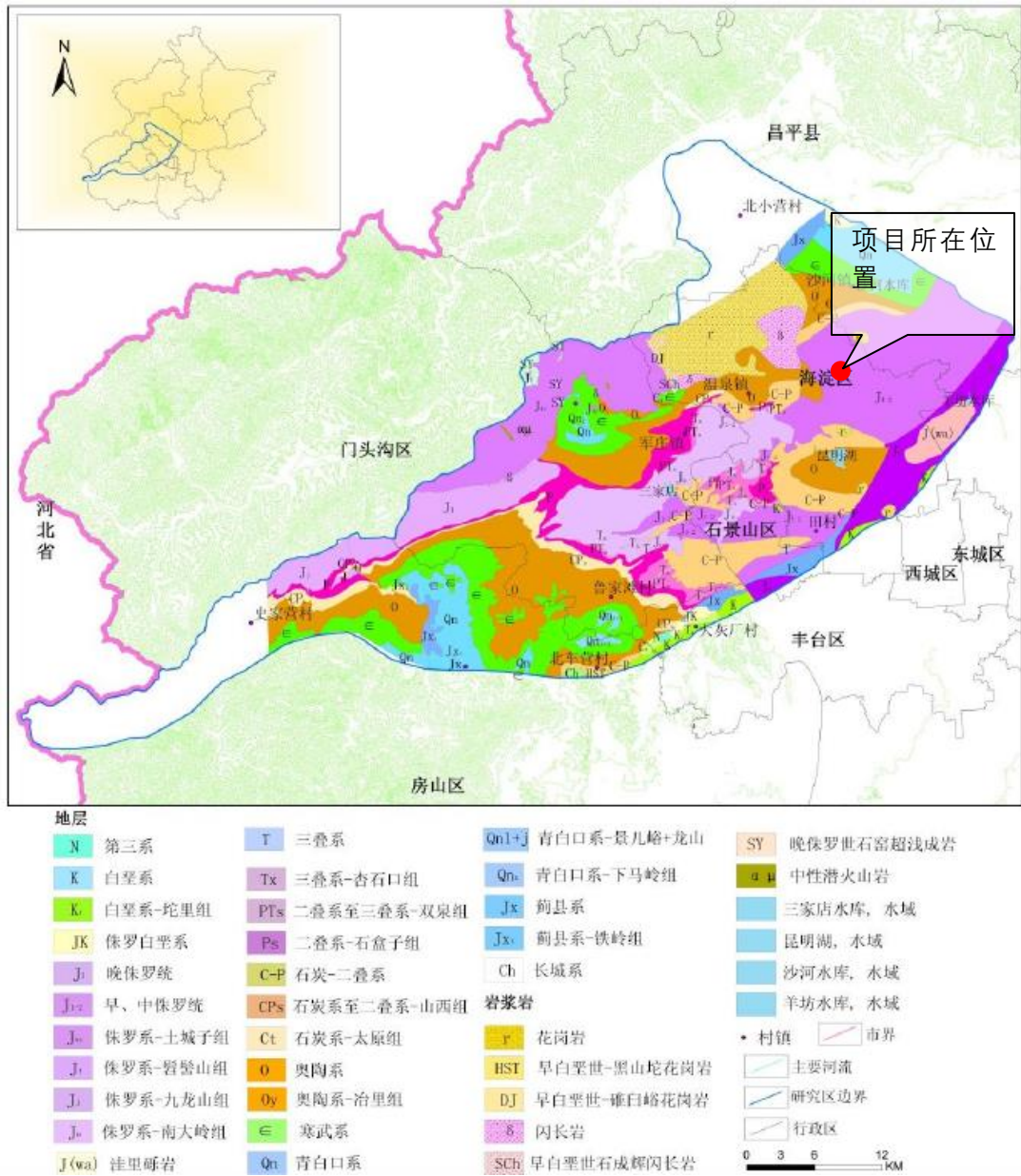


图 6 项目所在区域基岩地质图

2.1.3.2 气候

上地信息产业基地属暖温带半湿润季风气候，年平均气温为 13.28℃，全年平均降水量约为 508.9mm，年平均风速 2.5m/min 左右，风向频率多为北风。

2.1.3.3 区域水文与水文地质

海淀区境内有大小河流 10 条，总长度 119.8km，主要水系有高粱河、清河、

万泉河、南长河、小月河、南沙河、北沙河及人工开凿的永定河引水渠和京密引水渠，还有昆明湖、王渊潭、紫们院湖、上庄水库等水面，占北京市湖泊总数的20%；水域面积 4km²，占北京市水域面积的 41.28%，湖泊数量和水域面积均列北京市各区县之首，昆明湖是北京市最大的湖泊，水域面积 1.94km²。

本项目所在区域处于永定河的洪冲积地带，地形基本平坦，地层岩性主要为粘性土、粉土、砂土与卵石、圆砾的交互层，表层粘性土层的厚度一般小于 3m，粉土层的厚度一般小于 6m。该区域地表下分布 3-4 层地下水，地下水类型为潜水、承压水，局部地区有上层滞水，通常第一层含水层在埋深 3-6m，为台地潜水；第二层含水层在埋深 6-13m，为潜水；第三层含水层在埋深 11-21m，为层间水；含水层主要为含砾砂的中、细砂层，局部区域为砂卵石层。浅层地下水岩性以粉土、粉细砂为主，比较薄；深层地下水岩性以砂为主，层数较多且比较厚。该区地下水以上游地区地下水侧向径流补给为主，其次为大气降水，地表水的渗入补给和农灌水的回灌补给，垂直入渗率为 15%左右，由于含水层颗粒较粗，地下水径流条件较好，消耗于人工开采和以侧向径流形式流出本区补给下游地区、地下水。该区浅层地下水由西流向东，水位埋深 3m 左右，水力坡度 1.1%。项目所在区域的潜水水位等值线见图 7。

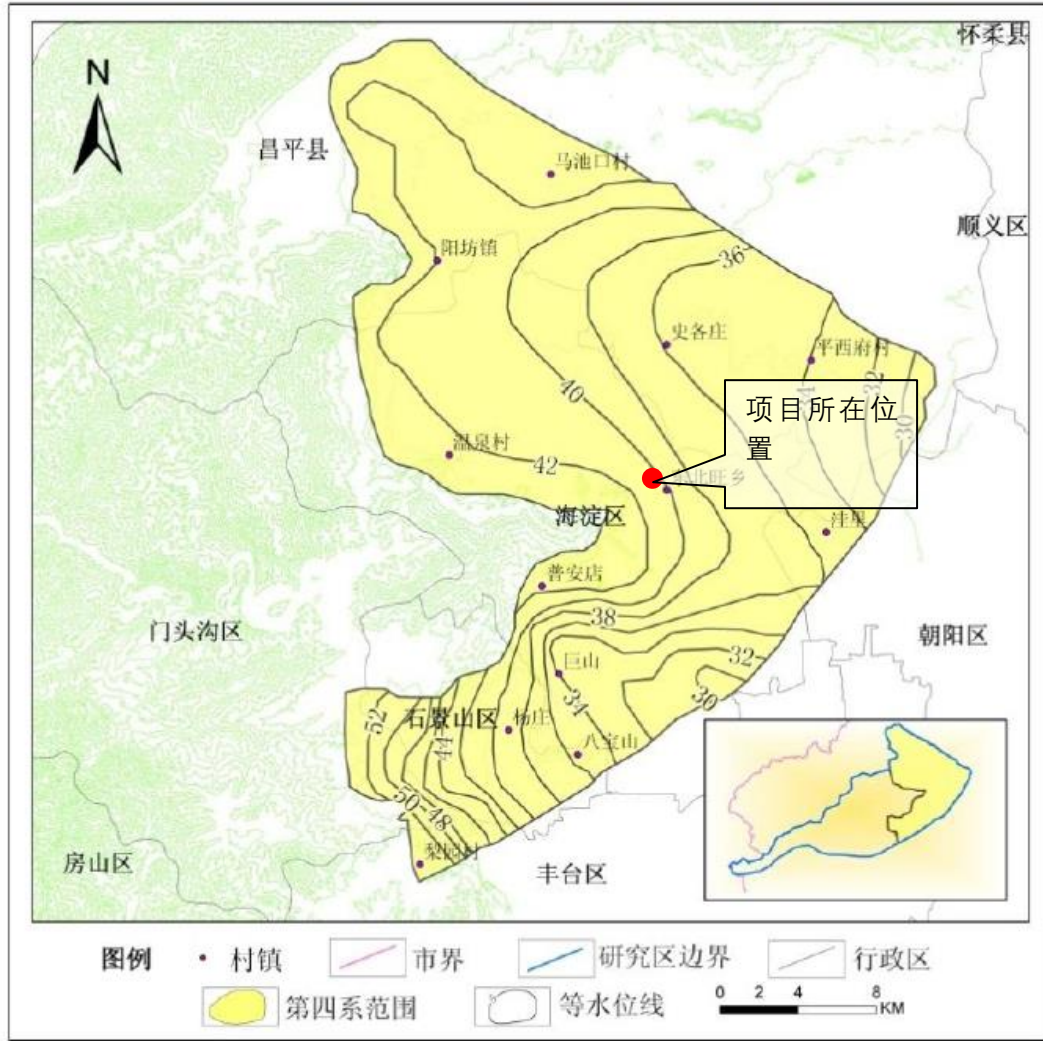


图 7 项目所在区域潜水含水层等水位线图

2.1.3.4 项目所在场地水文地质分布条件

根据《瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程岩土工程勘察报告》，勘察揭露深度 25 米范围内地层，表层土为人工填土，其下为一般第四纪冲洪积成因的粘性土、粉土砂类土。

项目地土壤从上至下为：①粉质粘土素填土层，黄褐色、湿、稍密，以粉质黏土为主，含灰渣、砖屑及植物根，本层厚度为 1.0~3.4 米。②粘质粉土层，褐黄色，稍湿，中密，含氧化铁、钙质等。局部夹砂质粉土、粉砂薄层，本层厚度为 2.3~5.2 米。③粉质黏土层，褐灰~黄灰色，可塑，含云母、有机质及钙质等，局部夹黏土薄层。本层厚度为 1.0~3.2 米。④细中砂层，褐黄色，稍湿，密实，主要矿物成分为石英、长石、云母。本层最大揭露厚度 9.0 米。⑤粉质黏土层，

褐黄色，含氧化铁等，本层最大揭露厚度 9.2 米。

现场钻探期间只有两个 25 米深的钻孔见地下水，地下水类型为潜水，初见水位埋深 20.3~20.4 米，标高 26.99~27.38 米；静止水位埋深 19.7~19.8 米，标高 27.49~27.88 米；主要补给来源是侧向径流，地下水流向自西向东。

项目地工程地质剖面图见图 8。

2.1.4 敏感受体信息

瑞萨半导体（北京）有限公司厂区北临上地九街、南邻上地八街、东临上地东路、西邻上地西路。项目敏感目标主要为厂区内倒班宿舍和厂区周边 500m 范围内的住宅区、学校。本项目具体敏感目标受体详见下表 6，周围 500m 环境概况图见图 9。

表 6 场地周边敏感目标

序号	环境敏感目标名称	方位	距场地距离 (m)
1	倒班宿舍	厂区内	--
2	西二旗智学苑	东侧	约 165 米
3	西二旗小学	东侧	约 180 米
4	西二旗润中苑	东南	约 260 米
5	领秀新硅谷	东北	约 280 米

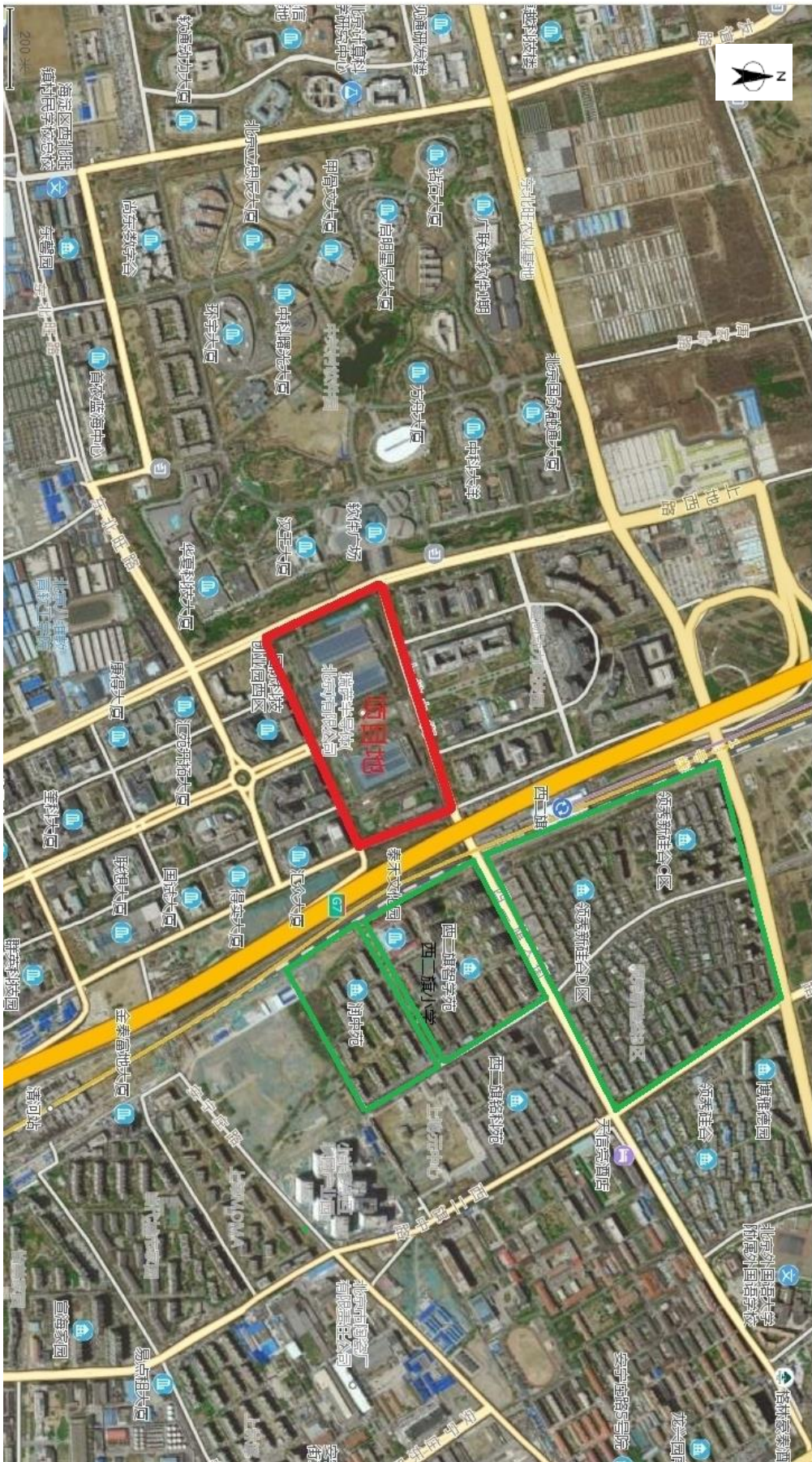


图9 场地周边敏感点分布图

2.1.5 已有环境调查与监测信息概况

厂区环境影响报告书土壤和地下水环境调查监测数据、其他调查评估数据等相关信息详见表 7。

表 7 已有环境调查与监测信息

序号	已有环境调查与监测信息	编制单位	时间	主要内容及结论
1	《三菱四通集成电路有限公司废水、废气和噪声环保验收监测报告》	北京市环境保护监测中心	1998 年 12 月	废气、噪声、废水的环保验收监测，监测结果达标。
2	《关于瑞萨四通集成电路一期扩建工程报告书项目环境保护验收的批复》(京环评价验字[2004]111 号)	北京市环境保护局	2004 年 11 月	进行了环保验收监测，符合相关国家及北京市相关环境保护规定。
3	《瑞萨半导体(北京)有限公司一期扩建第二工程》项目环境影响评价报告书	北京理化分析测试中心	2007 年年 8 月	废气、噪声、土壤的环保监测，土壤监测结果达标。
4	《北京市环保局关于瑞萨半导体(北京)有限公司一期扩建第二工程报告书项目环境保护验收的批复》(京环验[2013]48 号)	北京市环境保护局	2013 年 2 月	进行了环保验收监测，监测结果显示项目符合相关国家及北京市相关环境保护规定。
5	瑞萨半导体(北京)有限公司自行监测报告	谱尼测试集团股份有限公司	2018 年 1 月、4 月、7 月、10 月	公司自行进行的废气、噪声、废水的环保监测，监测结果达标。

2.2 现场踏勘及人员访谈

2.2.1 现场踏勘

在了解企业生产工艺、生产设施布局的前提下开展踏勘工作，踏勘以厂区内部为主。在踏勘过程中，了解厂区内设施、建筑物、构筑物，观察生产设备、各类管线、贮存容器、排污设施，通过辨识异常气味、污染痕迹等状况分析是否存在土壤污染，为后期厂区监测布点奠定基础。

现场踏勘结果：

①厂区内固体废物主要为生活垃圾、废边角料、废机油、污水站污泥等，其中危险废物有专门的危险废物暂存间放置；

②厂区设备管道连接处及设备管道与墙体连接处没有滴漏现象；

③生产车间、污水处理车间、危废暂存间等处内部采取了地面硬化、防渗措施；

④厂区内环境整洁，道路硬化、土地绿化情况较好，各部分区域没有明显污染痕迹；

⑤厂区内没有明显异味。

2.2.2 人员访谈

在厂区内还通过人员访谈了解厂区的历史情况。人员访谈主要通过当面访谈、电话交流等形式向厂区现状或者历史知情人进一步了解厂区内情况，目的是补充和确认监测区域的使用信息，及核查所收集到的环境资料的有效性。

根据前期资料的搜集，对瑞萨半导体（北京）有限公司厂区进行相关人员访谈，访谈对象主要为厂区工作人员等。

访谈内容基本概括如下：

①公司前身为三菱四通集成电路有限公司，2005年10月，更名为瑞萨半导体（北京）有限公司，主要从事集成电路的后封装、测试生产制造；

②厂区内原辅材料主要包括框架、树脂、镀料、硫酸、硝酸、金线、电镀液、托盘等；

③自建厂至今未发生过环境风险事故；

④自建厂至今未曾因非法排污或污染物排放不达标被相关环境主管部门处罚过；

⑤厂区周边相邻地块未曾发生过化学品泄漏事故及其他环境污染事故；

⑥厂区周边500m范围内敏感用地主要是学校及住宅区；

⑦厂区污水排放全部通过地下污水管道。

2.3 潜在污染区域识别

2.3.1 疑似污染源区域识别方法

参考下列次序识别污染区域及其疑似污染程度，也可根据地块实际情况进行确定：

- (1) 根据已有资料或前期调查结果表明存在污染的区域；
- (2) 曾发生泄露或环境污染的区域；
- (3) 各类管槽、线路、集水井、检查井等所在区域；
- (4) 固体废物堆放或填埋的区域；
- (5) 原辅材料、产品、化学品、有毒有害物质以及危险废物等生产、贮存、装卸、使用和处置的区域；
- (6) 其他存在明显污染痕迹或存在异味的区域。

2.3.2 重点区域及设施识别

根据资料总结和现场踏勘结果，厂区内现状主要存在 13 个区域，见图 10、表 8：

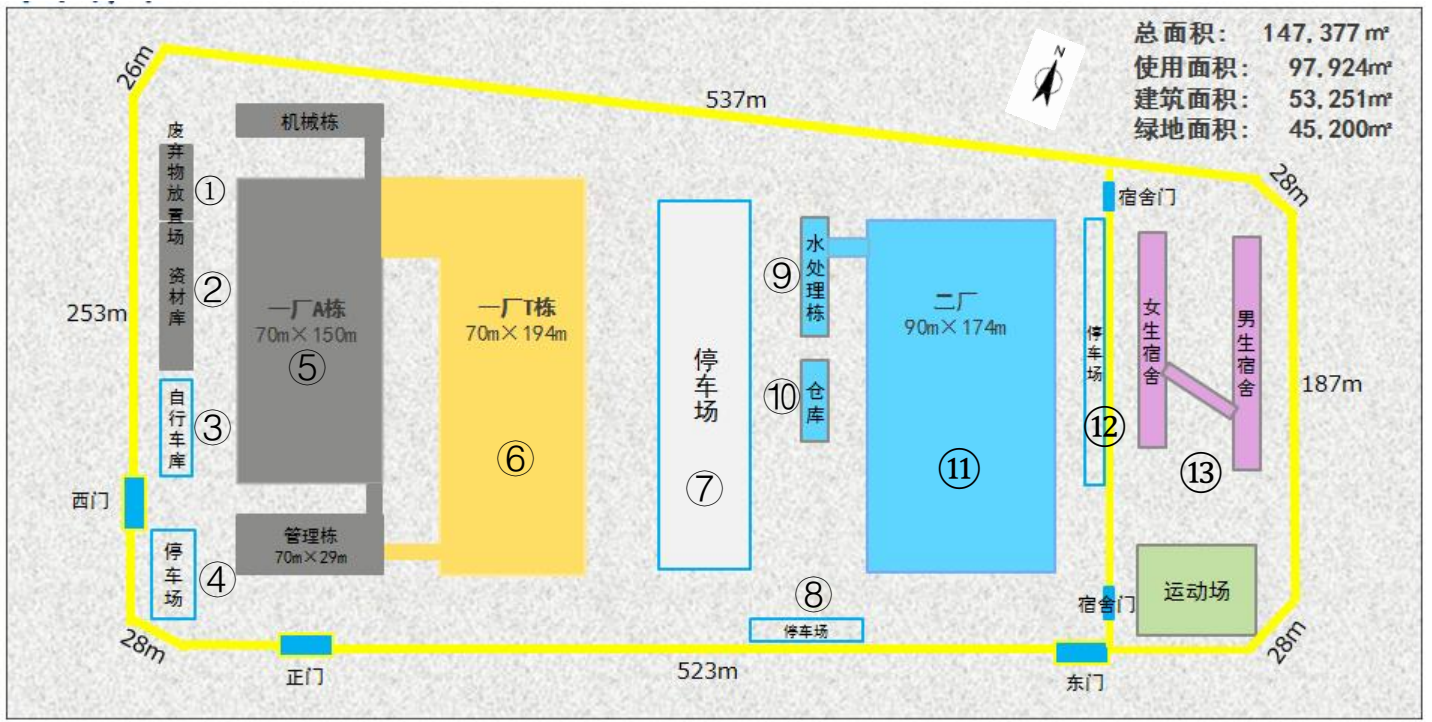


图 10 厂区区域识别

表 8 厂区区域识别

编号	名称	重点设施或污染物	备注
①	一厂废弃物放置场	固废	危险废物储存处(废机油、废电镀液、废水处理污泥等)
②	资材库	现状为厂区工会	原为化学品库(硫酸、硝酸等)
③	自行车库	无	-
④	停车场	无	-
⑤	一厂 A 栋厂房	厂房内部有电镀生产线	北侧机械栋原为一厂污水处理站, 自 2017 年后闲置至今, 现废水由二厂水处理栋处理
⑥	一厂 T 栋厂房	北侧闲置, 南侧出租给瑞萨总公司旗下 RDB 研发及 RECH 销售部门, 现状无生产设施	T 栋原为测试车间, 没有从事过生产
⑦	停车场	无	-
⑧	停车场	无	-
⑨	水处理栋	废水处理设施	内部地面硬化、采取了防渗措施, 内部有危废暂存处(污泥)
⑩	仓库	现状一层闲置, 二层为化学品仓库	重点区域
⑪	二厂厂房	厂房内有生产测试设施及电镀生产线	重点区域
⑫	停车场	无	-
⑬	宿舍区(男、女宿舍及运动场)	无	-



厂区大门



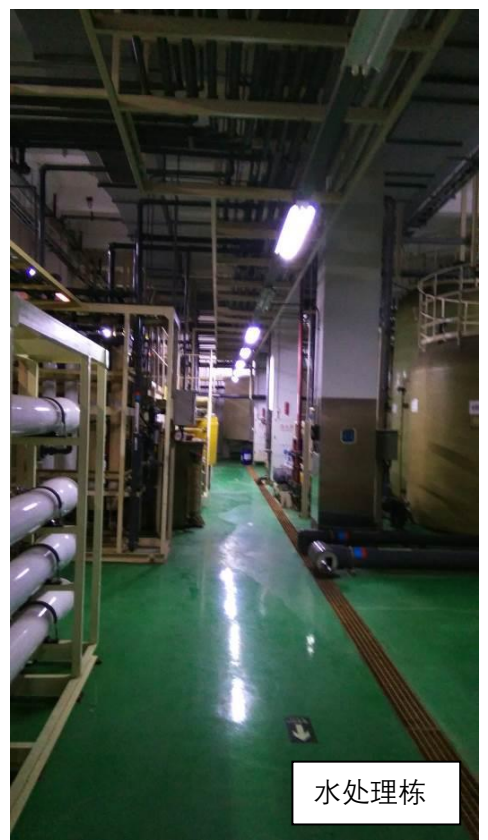
一厂区废弃物放置场



资材库 (现状工会)



生产车间



水处理栋



化学品库



厂区内部道路



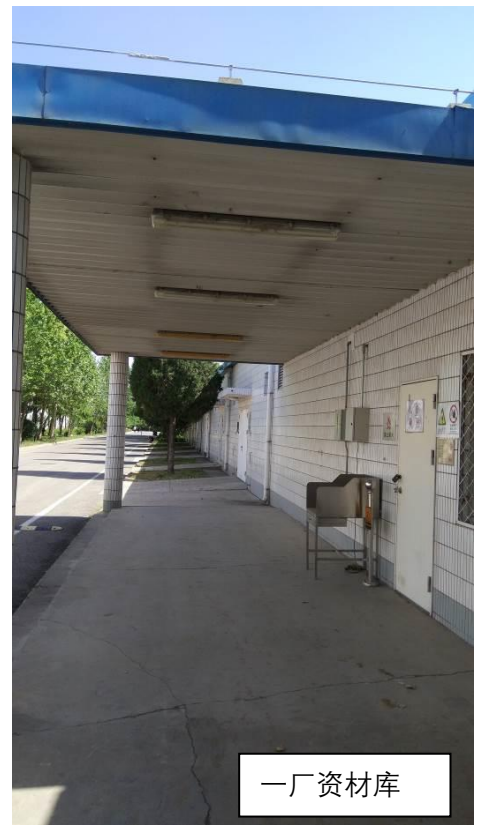
二厂厂房



一厂机械栋



二厂水处理栋



一厂资材库

除去停车场等区域，可将厂区内合并划分为 6 个主要区域，见图 11、表 9：

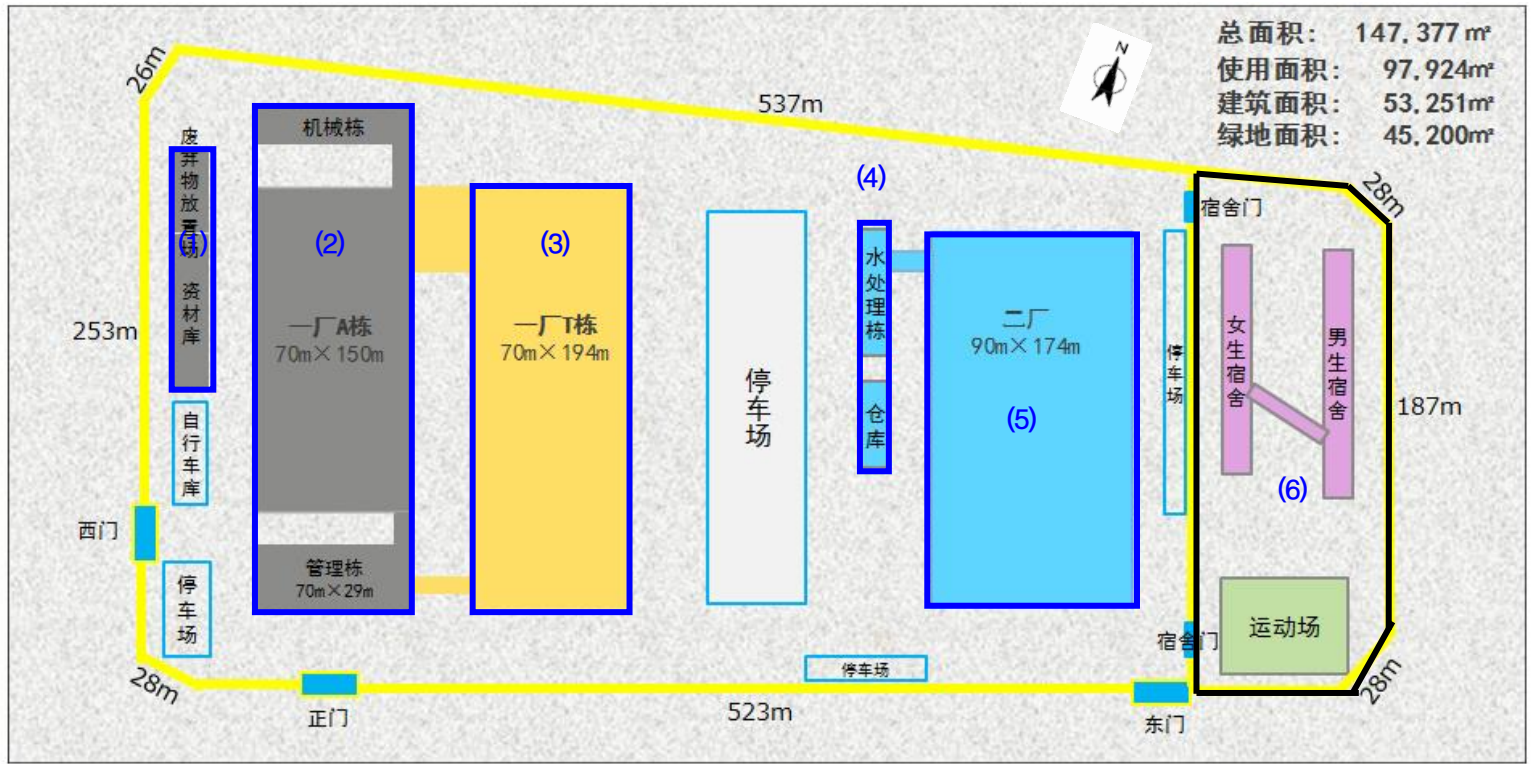


图 11 厂区区域划分

表 9 厂区区域划分

编号	识别依据	重点设施或污染物	备注
(1)	废弃物放置场 资材库	危废储存 原化学品库	重点区域
(2)	一厂 A 栋厂房	厂房内部有电镀生产线 北侧机械栋原为水处理车间	重点区域
(3)	一厂 T 栋厂房	无生产设施	-
(4)	水处理栋 仓库	废水处理设施 化学品库	重点区域
(5)	二厂厂房	厂房内有生产测试设施及电 镀生产线	重点区域
(6)	宿舍区 (男、女宿舍及运动场)	无	-

2.3.3 潜在重点污染区域识别

根据历史资料、现场踏勘、人员访谈等信息进行分析、总结，参考疑似污染源区域识别方法，对照原辅材料使用情况，确定重点区域主要集中在废弃物放置区、生产厂房、水处理栋，主要污染物为重金属（铜、铅、镍、锡等）。重点区域识别情况详见下表10所示。

表10 潜在污染区域信息

	区域编号		名称	瑞萨半导体（北京）有限公司	
	重点区域	(1)	①	废弃物放置场	危废储存
②			资材库	原化学品库	硫酸、硝酸
(2)		⑤	一厂 A 栋厂房	生产	重金属
(4)		⑨	水处理栋	处理电镀废水等	重金属
		⑩	仓库	现化学品库	硫酸、硝酸
(5)		⑪	二厂厂房	生产	重金属

I. 区域（1）：一厂 A 栋西侧有一处废弃物放置场①，用以存放生产产生的危险废物；一厂 A 栋西侧有一处资材库②，现状用做公会，但原为化学品库，因此将区域（1）设置为重点监测区域；

II.区域（2）：一厂 A 栋厂房⑤内部有电镀生产线，北侧机械栋原为污水处理车间，因此，将该区域（2）设置为重点监测区域；

III.区域（4）：二厂房西侧有一水处理栋⑨，主要处理项目产生的生产废水，包括划片废水、电镀废水、酸碱废水及一般排水（冷却塔废水和洗衣废水），生产废水经处理装置处理达标后排入市政管网；二厂房西侧有一仓库⑩，现状一层闲置，二层为化学品库，因此，将该区域（4）设置为重点监测区域；

IV.区域（5）：二厂厂房⑪内进行压焊、测试、电镀生产，因此，将该区域（5）设置为重点监测区域。

3 自行监测计划

依据《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》（以下简称《技术指南》），通过现场踏勘、人员访谈、收集厂区资料及信息制定本监测计划：包括核查已有信息、制定监测采样方案、制定样品分析方案、制定质量保证和质量控制程序等内容。

按照《技术指南》中的相关要求进行实地走访调查及现场踏勘，现场踏勘及污染状况识别结束后，进入制定自行监测方案阶段。

3.1 监测范围、监测对象、监测因子及监测频率

3.1.1 监测范围

本次调查地块为瑞萨半导体（北京）有限公司厂区，厂区位于北京市海淀区上地八街7号信息产业基地用地范围内，北临上地九街、南邻上地八街、东临上地东路、西邻上地西路。

3.1.2 监测对象

本次调查监测对象为瑞萨半导体（北京）有限公司厂区范围内的土壤、地下水。

3.1.3 监测因子

本项目设备维修会产生废机油，但产生量很小，且都发生在厂房内部，厂房地面硬化及防渗措施完好，厂区内地面未见油渍，因此无需进行石油烃监测。

本项目生产不涉及挥发性有机物，因此无需进行土壤气监测。

依据企业生产类别以及原辅材料分析，疑似污染区域识别的特征污染物主要为：pH 和铜、铅、镍、锡等重金属；同时根据《技术指南》附录 2 中给出的金属表面处理及热处理加工（336）类项目可能存在的特征污染物包括：A1（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、A2（锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼）、D1（pH）。

根据对本项目的原辅料分析和产排污分析，项目基本不涉及 A2（锰、钴、硒、钒、铋、铊、铍、铟）等几项重金属；本项目特征污染物有金属锡，虽然《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》附录 2 中并未包含锡，但是本项目为了全面了解厂区的土壤环境情况，对金属锡也进行检测。因此本项目监测因子选取：

土壤监测因子：A1（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、D1（pH）、锡。

地下水监测因子：A1（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、D1（pH）、锡。

3.1.4 监测频率

根据《技术指南》2.5 条规定，土壤环境重点监管企业每年至少开展一次土壤一般监测和地下水监测。

3.2 监测采样方案

3.2.1 土壤监测布点原则与方法

（1）土壤监测布点原则

①代表性：采样应以采集代表性样品为主要原则，采样位置合理性控制；

②针对性：点位布设应根据地块现场踏勘的实际情况，尽可能选择最有可能受到污染影响的区块布设样点，还必须考虑到区块外界可能对区块内产生潜在的影响地块。

（2）土壤监测布点方法

根据《技术指南》相关规定，原则上每个重点区域或设施周边应至少布设 1-3 个土壤采样点。样品的具体数量可根据布点区域大小、污染物分布等实际情况进行适当调整。土壤监测应以监测区域内表层土壤（0.2m 处）为重点采样层，开展采样工作应在企业外部区域或企业内远离各重点区域及设施处布设至少 1 个土壤背景监测点。并随机抽取 10%-20% 的样品进行平行双样测定。

（3）现场土壤监测布点结果

按照《技术指南》规定，结合前期资料、现场踏勘、人员访谈及厂区重点区域识别的结果，共计布设土壤监测点位 5 个，背景监测点 1 个（参照点）。

取样深度：所有采样点均取表层土，深度 0.2m；S2 点位于原污水处理站西侧，污水处理站内有地下废水储槽 3.1m 深，在储槽下 1m 深取样，取样深度 4.1m；S3 点位附近有污水管线，管线埋深 1m，在管线下 1m 取深层土，取样深度 2m；S4 点位于水处理栋东侧，水处理栋地下紧急废水储槽 4m 深，在储槽下 1m 深取样，取样深度 5m；S5 点位附近有污水管线，管线埋深 1m，在管线下 1m 取深层土，取样深度 2m；参照点 S0 同样需要取深层土，取样深度 5 米。详见表 11 所示。

表 11 土壤点位布设结果

序号	点位	取样深度 (m)	筛选依据	点位布设位置
1	S0	表层土 (0.2m) 深层土 (4m)	背景监测点	点位布设在厂区东侧宿舍区草坪上
2	S1	表层土 (0.2m)	一厂废弃物放置场、 资材库 (原化学品库)	点位布设在厂区西北角废弃物放置场、资材库西边草坪处
3	S2	表层土 (0.2m) 深层土 (4.1m)	一厂机械栋 (原水处理车间)	点位布设在机械栋西侧草坪处
4	S3	表层土 (0.2m) 深层土 (2m)	一厂 A 栋厂房	点位布设在一厂 A 栋厂房东侧草坪处
5	S4	表层土 (0.2m) 深层土 (5m)	水处理栋、化学品库	点位布设在水处理栋、二厂仓库东侧草坪处
6	S5	取表层土 (0.2m) 深层土 (2m)	二厂厂房	点位布设在二厂厂房东南侧草坪

3.2.2 地下水监测井监测布点原则与方法

(1) 地下水监测井监测布点原则

①有效控制性：以尽量控制监测单元区地下水特征为主，有效反映监测单元区地下水质量状况；

②查明地下水流向：以边界范围为控制，查明地下水的主要流向；

③迁移性：当地块内存在潜在污染源时，在现场踏勘的基础上，在潜在污染源区及其可能迁移线路沿途布设监测井；

④潜在污染鉴别：地块周边地区存在潜在污染因素时，需在靠近潜在污染源

区布设监测井；

⑤系统性：监测井成井过程中，应根据实际需要配套采集土壤和地下水样。

(2) 地下水监测井布点方法

根据《技术指南》相关规定，原则上，每个重点区域或设施周边应布设至少 1 个地下水监测点，具体数量应根据待监测区域大小及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。开展采样工作应在企业外部区域或企业内远离各重点区域及设施处布设至少 1 个地下水背景监测点。地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向，在同一个企业内部，监测井可以根据厂房及设施分布的情况统筹规划。处于同一污染物迁移途径上的相邻区域或设施可合并监测。监测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确定。当重点区域或设施的特征污染物为高密度污染物时，监测井进水口应设在隔水层之上，含水层的底部或者附近。地下水监测以调查第一含水层（潜水）为主。但在重点区域或设施识别过程中认为有可能对多个含水层产生污染的情况下，应对所有可能受到污染的含水层进行监测。

(3) 现场地下水监测井监测布点结果

结合前期资料收集、现场踏勘、人员访谈及厂区疑似污染区域识别的结果，共计布设了 2 个地下水监测井、1 个地下水背景监测井。

项目地内浅层地下水流向为自西向东，因此地下水背景监测井设在厂区最西侧上游流向位置（和土壤监测点 S1 设在同一个点位同时取样）；同时在二厂水处理栋东侧（和土壤监测点 S4 设在同一个点位同时取样）和二厂区厂房东南侧（和土壤监测点 S5 设在同一个点位同时取样）各设一个地下水监测井。项目监测布点图见图 12。

(4) 地下水监测井建设

在产企业地下水采样井应建成长期监测井。监测井的建设方法可参照《北京市场地环境评价导则》（DB11/T 656）的要求进行。

为防止监测井物理破坏，防止地表水、污染物质进入，监测井应建有井台、井口保护管、锁盖等。井台构筑通常分为明显式和隐藏式井台，隐藏式井台与地面齐平，适用于路面等特殊位置。

监测井存档资料包括设计、原始记录、成果资料、竣工报告、建井验收书的

纸介质和电子文档。

应指派专人对监测井的设施进行经常性维护，设施一经损坏，必须及时修复。

地下水监测井每年测量井深一次，当监测井内淤积物没过滤水管或井内水深小于 1m 时，应及时清淤。

监测井标识牌、井口固定点标志和孔口保护帽等配套设施发生移位或损坏时，必须及时修复。

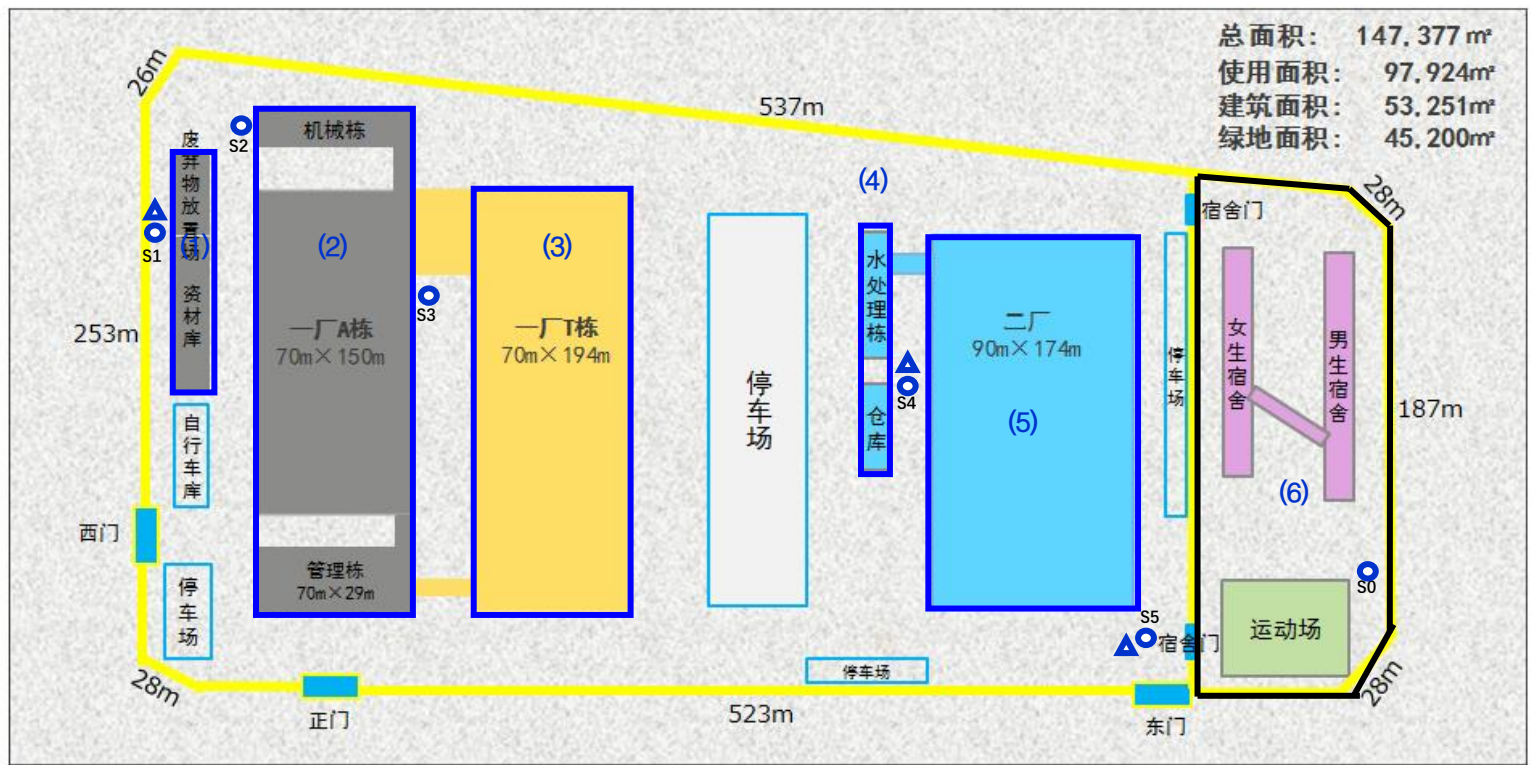


图 12 监测布点图

图例：○ 土壤监测点
△ 地下水监测点

3.3 采样、保存、流转措施

3.3.1 采样措施

(1) 土壤采样

土壤样品采集方法参照《场地环境监测技术导则》(HJ25.2) 的要求进行。

(2) 地下水采样计划

地下水样品采集方法参照《北京场地环境评价导则》(DB11/T 656) 的要求

进行。

3.3.2 保存措施

样品保存涉及采样现场样品保存、样品暂存保存和样品流转保存要求，应遵循以下原则进行：

(1) 实验室土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166) 要求进行，地下水样品保存可参照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164) 要求进行。

(2) 现场样品保存。采样现场需配备样品保温箱，保温箱内放置冷冻的蓝冰，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在 4℃ 低温保存。

(3) 样品暂存保存。如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品用冷藏柜 4℃ 低温保存，冷藏柜温度调至 4℃。

(4) 样品流转保存。样品寄送到实验室的流转过程保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，4℃ 低温保存流转。

3.3.3 流转措施

在采样小组分工中明确现场核对负责人，装运前进行样品清点核对，逐件与采样记录单进行核对，保存核对记录，核对无误后分类装箱。如果样品清点结果与采样记录有任何不同，应及时查明原因，并进行说明。

样品装运并填写样品运送单，明确样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法、样品寄送人等信息。

样品流转运输的基本要求是保证样品安全和及时送达。样品应在保存时限内应尽快运送至检测实验室。运输过程中要有样品箱并做好适当的减震隔离，严防破损、混淆或沾污。

实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品运送单上签字确认。

3.4 实验室分析测试

监测样品的分析和测试工作应委托具有中国计量认证 (CMA) 资质的检测

机构进行。

样品的分析测试方法应优先选用国家或行业标准分析方法，尚无国家或行业标准分析方法的监测项目，可选用行业统一分析方法或行业规范。

3.5 质量保证与质量控制

重点企业自行监测过程的质量保证及质量控制，除应严格按照本指南的技术要求开展工作外，还应严格遵守所使用检测方法及所在实验室的质量控制要求，相应的质控报告应作为样品检测报告的技术附件。

3.6 监测结果分析

企业应依照本指南要求，设立土壤及地下水的监测点位，开展长期监测工作，如实记录监测数据并开展统计分析工作，对于以下情况：

1) 监测点中特征污染物浓度超过相应标准中与其用地性质或所属区域相对应的浓度限值的；

其中各监测对象应执行的相应标准如表 9 所示；

2) 监测点检出相应标准中未列出的特征污染物指标的；

3) 监测点中特征污染物的监测值与背景监测值相比有显著升高的；

4) 某一期间（1 年以上）监测点中同一污染物监测值变化总体呈显著上升趋势的。

除能够证明是由于采样、分析或统计分析误差、土壤或地下水自然波动的正常范围，土壤环境本底值或企业外部污染源产生的污染造成的情况外，均可说明该污染源已存在污染迹象，此时应立即排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；同时依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》所述方法，启动土壤或地下水风险评估工作，根据风险评估的结果采取相应的风险管控或修复措施，防止污染物的进一步扩散。

表 12 各监测对象相应监测标准

监测对象		执行标准
土壤	一般监测	北京市场地土壤环境风险评价筛选值（DB11/T 811）

3.7 监测报告编制

企业应当结合重点监管企业年度自行监测报告，增加土壤环境自行监测相关内容，并按要求信息公开。土壤环境自行监测内容主要包括：

- 1) 监测点位的布设情况；
- 2) 各点位选取的特征污染物测试项目及选取原因；
- 3) 监测结果及分析；
- 4) 企业针对监测结果拟采取的主要措施。